سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
اثر ناخالصی بر TMR و مشخصهی I-V در نانو ساختارهای مغناطیسی

محل انتشار:
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴ (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 3

نویسنده:
فرامرز کنجوری - *دانشکده فیزیک دانشگاه یزد ، یزد*

خلاصه مقاله:
مقالهی حاضر به بررسی نظری اثر ناخالصی نقطهای درون یک لایهی دیالکتریک (I) که بین دو الکترود فرومغناطیس (F) قرار دارد، بر مشخصهی ولت - آمپر و مقاومت مغناطیسی تونلی(TMR) میپردازد . نشان داده شده است که جریان و TMR در نزدیکی ناخالصی به شدت افزایش مییابد . همچنین اگر مکان ناخالصی درون دی الکتریک نسبت به مرز لایهها متقارن نباشد،I-V رفتاری دیودگونه خواهد داشت .

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/26010